# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-071987

(43) Date of publication of application: 12.03.2002

(51)Int.CI.

G02B 6/13

(21)Application number: 2000-253606

(71)Applicant: NTT ADVANCED TECHNOLOGY

CORP

(22)Date of filing:

24.08.2000

(72)Inventor: MURATA NORIO

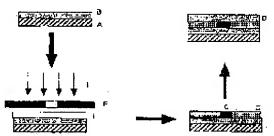
**IMAMURA SABURO** 

### (54) METHOD FOR MANUFACTURING OPTICAL WAVEGUIDE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an easy method of manufacturing an optical waveguide such that the core part is formed by irradiation with light, the clad part is formed by heating and that reactive ion etching in oxygen gas in a conventional photolithographic process or a process of removing a solvent by using a dissolving agent are made unnecessary.

SOLUTION: In the method of manufacturing an optical waveguide, after a substrate made of a first low refractive index resin or first low refractive index glass is coated with a thermosetting/UV-curing resin with a high refractive index containing a photopolymerization initiator and a thermal polymerization initiator, the resin is irradiated with light by using a photomask to form a core part and then the unhardened part is hardened by heating to form the side clad part. Furthermore, a high refractive index resin is applied thereon and hardened by heating or laminated with a low refractive index glass to form the upper clad.



heating or laminated with a low retractive index glass to form the upper

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-71987 (P2002-71987A)

(43)公開日 平成14年3月12日(2002.3.12)

(51) Int.Cl.7

識別記号

G02B 6/13

 $\mathbf{F}$  I

G 0 2 B 6/12

テーマコード(参考)

M 2H047

#### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2000-253606(P2000-253606)

(22)出願日

平成12年8月24日(2000.8.24)

(71)出願人 000102739

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ

株式会社

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

(72)発明者 村田 則夫

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 エ ヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株

式会社内

(72)発明者 今村 三郎

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 エ ヌ・ティ・ティ・アドパンステクノロジ株

式会社内

Fターム(参考) 2H047 KA04 PA01 PA22 PA26 PA28

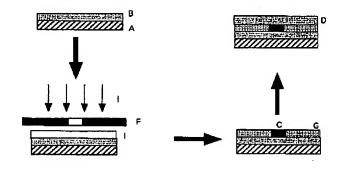
QA05 QA07 TA43

#### (54) 【発明の名称】 光導波路の作製方法

#### (57) 【要約】

【課題】 本発明の目的は、光照射でコア部を形成、加熱でクラッド部を形成し、従来のフォトリソプロセスの酸素ガス中での反応性リアクティブイオンエッチングや溶剤を使用した溶媒除去プロセスを不要とした簡便な光導波路の作成方法を提供することにある。

【解決手段】 本発明による光導波路の作成方法は、第1の低屈折率樹脂あるいは第1の低屈折率ガラスで形成された基板上に、光重合開始剤及び熱重合開始剤を含む高屈折率の熱・紫外線硬化樹脂をコーテング後、まず、フォトマスクを使用して光照射によりコア部を形成し、次に、未硬化部分を加熱硬化し、側面のクラッド部を形成し、更に、高屈折率樹脂をコーテングし、加熱硬化するかあるいは低屈折率ガラスを張り合わせて、上部クラッドを形成することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の低屈折率樹脂又は第1の低屈折率 ガラスで形成された基板上に、光重合開始剤及び熱重合 開始剤を含む高屈折率の熱・紫外線硬化樹脂をコーティ ング後、まず光照射によりコア部を形成し、次に未照射 部を加熱硬化して側面のクラッド部を形成し、さらにこ の層の上に第2の低屈折率樹脂をコーティング、貼りあ わせ又は第2の低屈折率ガラスを貼りあわせて上部クラ ッドを形成することを特徴とする光導波路の作製方法。

【請求項2】 請求項1に記載の第1の低屈折率樹脂又 10 は/及び第2の低屈折率樹脂を加熱硬化して下部クラッ ド又は/及び上部クラッドを形成することを特徴とする 光導波路の作製方法。

請求項1又は2に記載の高屈折率の熱・ 【請求項3】 紫外線硬化樹脂は、エポキシ系化合物あるいはオキセタ ン系化合物あるいはビニルエーテル系化合物あるいはそ れらの混合物と光重合開始剤及び熱重合開始剤からなる ことを特徴とする光導波路の作製方法。

【請求項4】 請求項1又は2に記載の第1の低屈折率 樹脂又は/及び第2の低屈折率樹脂として、エポキシ系 20 化合物あるいはオキセタン化合物あるいはビニルエーテ ル系化合物あるいはそれらの混合物と光重合開始剤又は /及び熱重合開始剤からなることを特徴とする光導波路 の作製方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光及び熱重合開始 剤を含む硬化性樹脂を用いた光導波路の作製方法に関す るものであり、光通信分野で用いられている光集積回路 や光情報処理分野で用いられている光配線板などの光導 30 波路部品を、大量・安価に製造することが期待できる。

[0002]

【従来の技術】光導波路は、基板の表面もしくは基板表 面直下に、周囲よりわずかに屈折率の高い部分を作るこ とにより光を閉じ込め、光の合波・分波やスイッチング などを行う特殊な光部品である。

【0003】光導波路デバイスの特長は、基本的には1 本1本の光ファイバを加工して作る光ファイバ部品と比 較して、精密に設計された導波回路を基に高機能をコン パクトに実現できること、量産が可能であること、多種 40 類の光導波路を1つのチップに集積可能であること等に ある。

【0004】従来から、光導波路材料として、透明性に 優れ光学異方性の小さい無機ガラスが主に用いられてき た。しかしながら、無機ガラスは、重く破損しやすく、 生産コストが高い等の問題を有しているので、最近では 無機ガラスの代わりに、可視域で極めて優れた透明性を 有し、通信波長域でも $0.8\mu m$ 、 $1.3\mu m$ 、1.55 μ m に窓のある透明性高分子を使って光導波路部品を

料はスピンコート法やディップ法等による薄膜形成が容 易であり、大きな面積の光導波路を作製するのに適して いる。また、石英等の無機ガラス材料を用いる場合とは 異なり、高分子材料を用いる場合は成膜に際して高温の 熱処理工程を含まないので、プラスチック基板などの高 温処理に適さない基板上にも光導波路を作製することが できるという利点がある。さらに、高分子の柔軟性や強 靭性を活かした基板フリーの高分子光導波路フィルムの 作製も可能である。また、製造が基本的に低温プロセス であったり、金型を用いた量産など複製化への展開が容 易であるので、高分子材料を用いた光導波路はガラス系 や半導体系の光導波路に比べて低コスト化に対するポテ ンシャルが高い。

2

【0005】特に、近年、光配線いわゆる光インタコネ クションの分野では、光導波路フィルムを用いた多ポー トの光送受信モジュールが開発され、テープ状に多芯化 された光ファイバとセットにされて光並列伝送のキー部 品となりつつある。

【0006】こうしたことから、光通信分野で用いられ る光集積回路や、光情報処理分野で用いられる光配線板 等の光導波路部品を、高分子光学材料を用いて大量・安 価に製造することが期待されている。

【0007】また、最近、エポキシ樹脂の紫外線硬化を 用いた立体光導波回路や光造形法、金型を使用した樹脂 キャスティング法やスタンパ法による光導波路作製の試 みがある。しかし、精度や量産性に問題があり、実用に 供せられるレベルのものは未だ得られていない。

【0008】将来、光導波路が光通信機器、光コンピュ ータ等の光処理装置や光伝送用ファイバとのインターフ エースとして使われることを想定すれば、精度や量産性 に優れた光導波路およびその製造方法を確立することが 望まれる。

【0009】図2は、従来の導波路の作製方法を示す工 程図である。図2において、Aは基板、Bは下部クラッ ド、Cはコア部、Dは上部クラッド、Eはレジスト、F はマスクを示す。(1)任意の基板Aに下部クラッドB となるコア部よりも屈折率の小さな樹脂を塗布する。塗 布後、加熱乾燥などにより溶媒を除去する。(2)この 上にコア部となる樹脂Hをコートする。(3)フォトプ ロセスにより、レジストEにマスクFと紫外線露光を用 いてパターンを形成し、酸素ガス中での反応性リアクテ ィブイオンエッチングを行った後、レジストEを除去す ることにより光導波路のコア部 Cを形成する。 (4)上 部クラッド用の紫外線硬化樹脂又は熱硬化樹脂を塗布 し、(5)紫外線照射又は加熱により硬化し上部クラッ ドDを形成する。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、光照 射でコア部を形成、加熱でクラッド部を形成し、従来の 製造しようという動きが活発化してきている。高分子材 50 フォトリソプロセスの酸素ガス中での反応性リアクティ

ブイオンエッチングや溶剤を使用した溶媒除去プロセス を不要とした簡便な光導波路の作成方法を提供すること にある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明による光導波路の作成方法は、第1に、第1 の低屈折率樹脂あるいは第1の低屈折率ガラスで形成さ れた基板上に、光重合開始剤及び熱重合開始剤を含む高 屈折率の熱・紫外線硬化樹脂をコーテング後、まず、フ ォトマスクを使用して光照射によりコア部を形成し、次 10 族環状エポキシ樹脂とビスフェノール型エポキシ樹脂は に、未硬化部分を加熱硬化し、側面のクラッド部を形成 し、更に、高屈折率樹脂をコーテングし、加熱硬化する かあるいは低屈折率ガラスを張り合わせて、上部クラッ ドを形成することを特徴とする。

【0012】第2に、低屈折率および高屈折率の熱・紫 外線硬化樹脂として、エポキシ系化合物あるいはオキセ タン化合物あるいはビニルエーテル系化合物あるいはそ れらの混合物と光および熱重合開始剤からなる組成物を 用いることを特徴とする。

【0013】本発明の原理は、エポキシ化合物やオキセ 20 タン化合物やビニルエーテル系化合物あるいはそれらの 混合物からなる熱・紫外線硬化樹脂(熱硬化及び紫外線 硬化の両性質を有する樹脂)における反応性の差を利用 することにより、光導波路を作製することにある。詳し くは、紫外線硬化した場合と熱硬化した場合、反応性の 差から、架橋密度が異なる硬化物ができ、密度に差がで きるために、硬化物の屈折率に差が出る。すなわち、前 者の紫外線硬化に比べ、後者の熱硬化では、架橋密度が 小さくなり屈折率が小さくなる。従って、紫外線硬化で コア部を形成し、周囲のクラッド部を熱硬化で形成する 30 ことで、光導波路を作製できる。

## [0014]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の導波路の作製方 法を示す行程図である。図1において、Aは基板(基板 Aが下部クラッドBを兼ねる場合もある)、Bは下部ク ラッド、Cはコア部、Dは上部クラッド、Fはマスク、 Gは側面のクラッド部を示す。(1)第1の低屈折率樹 脂あるいは第1の低屈折率ガラスで形成された平面基板 (この例では基板が下部クラッドを兼ねているが、基板 上に下部クラッドを形成したものを用いることも有る。 又、プラスチック基板では曲面状の基板も可能であ る。) 上に、コア部となる高屈折率の熱・紫外線硬化樹 脂を所定厚さ塗布する。(2)フォトプロセス(マスク Eを用いた紫外線露光)により、光導波路のコア部Cを 形成し、次いで、熱により未硬化の部分を硬化し、側面 のクラッド部Gを形成する。(3)熱・紫外線硬化樹脂 (第2の低屈折率樹脂)を所定厚さ塗布し、加熱により 硬化し、上部クラッドDを形成する。

【0015】更に、多層の光配線を行う場合は、(1) に代えて、低屈折率樹脂あるいは低屈折率ガラスを形成 50 する工程と、(2)、(3)の工程を繰返せば、多層の 光配線を容易に形成出来る。

【0016】本発明における樹脂組成物(熱・紫外線硬 化樹脂)にはベースとなる樹脂(オリゴマやモノマ)及 び熱・紫外線硬化(重合開始)剤が必須であり、ベース となる樹脂として、従来のエポキシやオキセタンやビニ ルエーテル、又はその混合物や変性物を使用できるが、 その他の構成要素として、例えば、希釈剤、カップリン グ剤等を含んでもよい。ベースとなる樹脂として、脂肪 単独で用いても良いし、混合物として用いてもよい。

【0017】本発明の樹脂組成物でベースとなる樹脂の うち、エポキシ系化合物として、

(1) 脂肪族環状エポキシ化合物として使用されるエポ キシ化合物の例としては、3,4-エポキシシクロヘキ シルメチル-3、4-エポキシシクロヘキサンカルボキ シレート、3,4-エポキシシクロヘキシルエチルー 3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビ ニルシクロヘキセンジオキシド、アリルシクロヘキセン ジオキシド、3,4-エポキシ-4-メチルシクロヘキ シルー2ープロピレンオキシド、2-(3,4-エポキ シシクロヘキシルー5,5-スピロー3,4-エポキ シ) シクロヘキサン-m-ジオキサン、ピス(3, 4-エポキシシクロヘキシル)アジペート、ビス(3,4-エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、ビス

(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エーテル、ビス (3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル)エーテル、 ビス(3,4-エポキシシクロヘキシル)ジエチルシロ キサンなどが挙げられる。

【0018】(2)ビスフェノール型エポキシ樹脂の例 としてはビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビス フェノールADジグリシジルエーテル、ピスフェノール Sジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールAジグリ シジルエーテル、ビスフェノールFジグリシジルエーテ ル、ビスフェノールGジグリシジルエーテル、テトラメ チルビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェ ノールヘキサフルオロアセトンジグリシジルエーテル、 ビスフェノールCジグリシジルエーテル等が挙げられ

【0019】(3)プロム化エポキシ樹脂の例として は、ジブロモメチルフェニルグリシジルエーテル、ジブ ロモフェニルグリシジルエーテル、プロモメチルフェニ ルグリシジルエーテル、プロモフェニルグリシジルエー テル、ジプロモメタクレシジルグリシジルエーテル、ジ ブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、 臭素化フェノールノボラック型エポキシ樹脂等が挙げら

【0020】(4)フッ素を含有するエポキシ系化合物 の例としては、

【化1】

40

6

Cn F2n+1のフルオロアルキル基を示す。

で表されるそれぞれシクロヘキサン型、ジフェニル型、 ベンゼン型エポキシ系化合物、あるいは、下記の一般式 ,のピスフェノール型エポキシ 【化2】

あるいは、下記に示すグリコール型エポキシ

で表されるフッ素を含有するエポキシ系化合物があげら れる。

【0021】(5)上記に挙げた脂肪族環状エポキシ、 ピスフェノール型エポキシ、フッ素化エポキシ以外に副 成分として種々のエポキシ樹脂を加えることができる。 加える樹脂はエポキシ基を持っていればどのような樹脂 でもよいが、例えば、ポリブタジエンジグリシジルエー テル、ポリー1、4-(2、3-エポキシブタン)-c 0-1, 2-(3, 4-x+2)-co-1, 4-7タジエンジオール、ネオペンチルグリコールジグリシジ 40 ルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエ ーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテ ル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、 フタル酸ジグリシジルエステル、トリメチロールプロパ ンポリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリグリシ ジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテ ル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、アリルグリ シジルエーテル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテ ル、フェニルグリシジルエーテル、フェノールペンタ

ブチルフェニルグリシジルエーテル、ラウリルアルコ ールペンタデカ (オキシエチレン) グリシジルエーテ ル、ソルビタンポリグリシジルエーテル、ペンタエリス リトールポリグリシジルエーテル、トリグリシジルトリ ス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート、レゾル シンジグリシジルエーテル、ポリテトラメチレングリコ ールジグリシジルエーテル、アジピン酸ジグリシジルエ ステル、ヒドロキノンジグリシジルエーテル、テレフタ ル酸ジグリシジルエステル、グリシジルフタルイミド、 セチルグリシジルエーテル、ステアリルグリシジルエー テル、pーオクチルフェニルグリシジルエーテル、pー フェニルフェニルグリシジルエーテル、グリシジルベン ゾエート、グリシジルアセテート、グリシジルブチレー ト、スピログリコールジグリシジルエーテル、1,3-ビスー〔1-(2,3-エポキシプロポキシ)-1-ト リフルオロメチルー2,2,2ートリフルオロエチル] ベンゼン、1, 4-ビス〔1-(2, 3-エポキシプロ ポキシ) -1-トリフルオロメチル-2, 2, 2-トリ フルオロエチル) ベンゼン、4,4'-ピス(2,3-(オキシエチレン) グリシジルエーテル、p-tert 50 エポキシプロポキシ) オクタフルオロビフェニル、テト

ラグリシジル-m-キシリレンジアミン、テトラグリシ ジルジアミノジフェニルメタン、トリグリシジルーパラ アミノフェノール、トリグリシジルーメタアミノフェノ ール、ジグリシジルアニリン、ジグリシジルトリブロム アニリン、テトラグリシジルビスアミノメチルシクロへ キサン、テトラフルオロプロピルグリシジルエーテル、 オクタフルオロペンチルグリシジルエーテル、ドデカフ ルオロオクチルジグリシジルエーテル、スチレンオキシ ド、リモネンジエポキシド、リモネンモノオキシド、α- ピネンエポキシド、β-ピネンエポキシドなどのエポ 10 キシ化合物が挙げられる。

【0022】本発明におけるオキセタン化合物として は、3-エチル-3ヒドロキシメチルオキセタン、1、 4-ビス((3-メチル-3-オキセタタニル)メトキ シ) ベンゼン、3-エチル-3-フェノキシメチル) オ キセタン、ジ(1-エチル(3-オキセタニル))メチ ルエーテル、3-エチル-3-(2-エチルヘキシロキ シメチル) オキセタンなどが挙げられる。

【0023】本発明におけるビニルエーテル系化合物と しては、1,4-ブタンジオールジビニロキシエチルエ 20 ーテル、ピスフェノールAジビニロキシエチルエーテ ル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、シクロ ヘキサンジメタノールジビニロルエーテル、ドデシルビ ニルエーテルなどが挙げられる。

【0024】本発明で使用する樹脂(ベースとなる樹 脂)の副成分として、エポキシの希釈剤や可撓性付与 剤、特性改質剤等の化合物を加えることができる。この ような化合物として例えば、ポリ(オキシエチレン)、 ポリ(オキシプロピレン)、ポリプロピレンオキシドト リオール、ポリカプロラクトントリオール、ポリブタジ 30 エンジオール、ポリブタジエンジグリシジルエーテル、 ポリー1, 4-(2, 3-エポキシブタン)-co-1, 2-(3, 4-エポキシ) -co-1, 4-ブタジ エンジオール、無水マレイン酸変性ポリブタジエン、ポ リブタジエンジアクリレート、ヒドロキシプロピルアク リレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、 1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、トリメチロ ールプロパンジアクリレート、β-ヒドロキシメチルメ タアクリレート、ネオペンチルグリコールジグリシジル エーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエー 40 テル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、 ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ジブ ロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、o - フタル酸グリシジルエステル、トリメチロールプロパ ンポリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリグリシ ジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテ ル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、アリルグリ シジルエーテル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテ ル、フェニルグリシジルエーテル、フェノールペンタ

ブチルフェニルグリシジルエーテル、ジブロモフェニ ルグリシジルエーテル、ラウリルアルコールペンタデカ (オキシエチレン) グリシジルエーテル、ソルビタンポ リグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールポリグリ シジルエーテル、トリグリシジルトリス(2-ヒドロキ シエチル) イソシアヌレート、レゾルシンジグリシジル エーテル、ポリテトラメチレングリコールジグリシジル エーテル、アジピン酸ジグリシジルエステル、ヒドロキ ノンジグリシジルエーテル、ピスフェノールSジグリシ ジルエーテル、テレフタル酸ジグリシジルエーテル、グ リシジルフタルイミド、ジブロモフェニルグリシジルエ ーテル、ジプロモネオペンチルグリコールジグリシジル エーテル、セチルグリシジルエーテル、ステアリルグリ シジルエーテル、p-オクチルフェニルグリシジルエー テル、p-フェニルフェニルグリシジルエーテル、グリ シジルベンゾエート、グリシジルアセテート、グリシジ ルプチレート、スピログリコールジグリシジルエーテ ル、ベンゼン酸グリシジルエステル、還元マルトースポ リグリシジルエーテルなどが挙げられる。これらの化合 物を単独あるいは混合して主成分に加えることにより樹 脂の特性を改質することができる。

【0025】本発明における光重合開始剤(光硬化剤) としては、紫外線によりエポキシ基と反応して、重合を 起こさせるものであれば何でもよいが、例えば、p-メ トキシベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロホスフェー ト等の芳香族ジアゾニウム塩、トリフェニルスルホニウ ムヘキサフルオロホスフェート等の芳香族スルホニウム 塩、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェー ト等の芳香族ヨードニウム塩、芳香族ヨードシル塩、芳 香族スルホキソニウム塩、メタロセン化合物などが挙げ

【0026】本発明における熱重合開始剤(熱硬化剤) としては、加熱することによりエポキシ基反応して、重 合を起こさせるもので、かつ光重合開始剤の反応を阻害 しないものであれば何でもよい。例えば、下記の化合物 から適当な物を選定することが出来る。ジエチレントリ アミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペン タミン等のポリアミン、ポリミチレンジアミン、メンセ ンジアミン等の脂肪族ポリアミン、メタフェニレンジア ミン、ジアミノジフェニルメタン等の芳香族アミン、あ るいはそれらの変性物等のアミン系硬化剤や、無水フタ ル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、無水 ベンゾフェノンテトラカルボン酸、エチレングリコール ビス(アンヒドロトリメリテート)、グリセロールトリ ス (アンヒドロトリメリテート)、△4-テトラヒドロ 無水フタル酸、4-メチル-△4-テトラヒドロ無水フ タル酸、3-メチル-△4-テトラヒドロ無水フタル 酸、無水ナジック酸、無水メチルナジック酸、4-(4 -メチル-3-ペンテニル) テトラヒドロ無水フタル (オキシエチレン) グリシジルエーテル、p-tert 50 酸、マレイン化脂肪酸、ドデセニル無水コハク酸、ビニ

アミノエチル) - γ-アミノプロピルトリメトキシシラ ン塩酸塩、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエト キシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、アークロロ プロピルトリメトキシシラン、ヘキサメチルジシラザ ン、ィーアニリノプロピルトリメトキシシラン、ビニル トリメトキシシラン、オクタデシルジメチル (3-(ト

リメトキシシリル)プロピル)アンモニウムクロリド、 カプトプロピルメチルジメトキシシラン、メチルトリク ロシラン、ビニルトリエトキシシラン、ベンジルトリメ チルシラン、ピニルトリス(2-メトキシエトキシ)シ ラン、γ-メタクリロキシプロピルトリス(2-メトキ シエトキシ)シラン、β-(3,4-エポキシシクロへ キシル) エチルトリメトキシシラン、アーウレイドプロ ピルトリエトキシシラン、ィーイソシアヌルプロピルト リエトキシシラン、n-オクチルトリエトキシシランな

10

[0028]

どが挙げられる。

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説 明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。なお 実施例中の(数字)部は重量部である。

[0029]

【実施例1】脂肪族環状エポキシである3、4-エポキ シシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキ サンカルボキシレート80部(ベースとなる樹脂)に、 エポキシ系反応性希釈剤20部、光重合開始剤として 4. 4-ビス (ジ (βヒドロキシエトキシ) フェニルス ルフォニオ) フェニルスルフィドーピスーヘキサフルオ ロアンチモネート2部、熱硬化剤としてベンジル基を有 する潜在性硬化剤のスルフォニウム塩系化合物1部、シ ランカップリング剤としてエポキシ系シラン1部を配合 し、熱・紫外線硬化樹脂を調製した(屈折率1.49 3)。シリコン基板上に、この調製した熱・紫外線硬化 樹脂をスピンコート法により20μmの厚さに積層し、 150℃2時間で硬化させ下部クラッド(屈折率1.5 17)を形成した。

【0030】次に、上記の調製した熱・紫外線硬化樹脂 をスピンコート法により8μmの厚さに積層し、フォト マスクを使用して、光量 5 0 mW/c m<sup>2</sup>の紫外線を 1 O分間照射して幅8μmの直線部を硬化させ、熱・光導 波路のコア部(屈折率1.530)を形成した。その 後、150℃2時間で未硬化部分を硬化させ、側面のク ラッド部を形成した。更に、本実施例で調製した熱・紫 外線硬化樹脂をスピンコート法により 20μmの厚さに 積層し、150℃2時間で硬化した。

【0031】本実施例で作製した光導波路の光損失を、 波長1300 n m の半導体レーザで調べたら、1.0 d B/cmであった。

[0032]

ルエーテル-無水マレイン酸共重合体、アルキルスチレ ン無水マレイン酸共重合体、メチルシクロヘキセンテト ラカルボン酸無水物、無水コハク酸、ヘキサヒドロ無水 フタル酸、4-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、3-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸等の酸無水物系硬化剤 や、2-メチルイミダゾール、2-エチル-4メチルイ ミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2-ヘプタ デシルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、1-ベンジルー2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル -2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-エ IO ロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロ チルー4-メチルイミダゾール、1-シアノエチルー2 ウンデシルイミダゾール、1-シアノエチル-2-ウン デシルイミダゾリウムトリメリテート、1-シアノエチ ルー2-フェニルイミダゾリウムトリメリテート、2-メチルイミダゾリウムイソシアヌレート、2-フェニル イミダゾリウムイソシアヌレート、2,4-ジアミノー 6 - [2-メチルイミダゾリル- (1)] -エチル-S ートリアジン、2、4ージアミノー6ー[2-エチルー 4-メチルイミダゾリルー(1)] -エチルーS-トリ アジン等のイミダゾール系硬化剤、BF3-n-ヘキシ 20 ルアミン、BF3-モノエチルアミン、BF3-ベンジ ルアミン、BF3-ジエチルアミン、BF3-ピペリジ ン、BF3-トリエチルアミン、BF3-アニリン、B F4-n-ヘキシルアミン、BF4-モノエチルアミ ン、BF4-ベンジルアミン、BF4-ジエチルアミ ン、BF4-ピペリジン、BF4-トリエチルアミン、 BF4-アニリン、PF5-エチルアミン、PF5-イ ソプロピルアミン、PF5-ブチルアミン、PF5-ラ ウリルアミン、PF5-ベンジルアミン、AsF5-ラ ウリルアミン等のルイス酸-アミン錯体系硬化剤、ジシ 30 アンジアミド及びその誘導体、有機酸ヒドラジッド、ジ アミノマレオニトリルとその誘導体、アミンイミド等の 硬化剤、潜在性熱硬化剤のスルフォニウム塩やホスフォ ニウム塩、ピリジニウム塩などがあげられる。これらの 硬化剤は単独で用いてもよいし、これらの混合物として 用いてもよい。そして、硬化促進剤として第3級アミ ン、硼酸エステル、ルイス酸、有機金属化合物、有機酸 金属塩、イミダゾール等を用いてもよい。

【0027】さらに、本発明の熱硬化樹脂に接着性を良 くするためにシランカップリング剤を加えることができ 40 る。シランカップリング剤の例としては、アーアミノプ ロピルトリエトキシシラン、N-β-(アミノエチル) - γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-β-(アミノエチル) - ア - アミノプロピルトリメトキシシ ラン、N-β-(アミノエチル)-β-(アミノエチル) - γ - アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ –メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γーメルカ プトプロピルトリエトキシシラン、アーメタクリロキシ プロピルトリメトキシシラン、ィーグリシドキシプロピ ルトリメトキシシラン、N-β-(N-ピニルベンジル 50

11

【実施例2】ビスフェノール型エポキシであるビスフェノールドジグリシジルエーテル80部(ベースとなる樹脂)に、エポキシ系反応性希釈剤20部、光重合開始剤として4.4ービス(ジ( $\beta$ ヒドロキシエトキシ)フェニルスルフォニオ)フェニルスルフィドービスーへキサフルオロアンチモネート2部、熱硬化剤としてベンジル基を有する潜在性硬化剤のスルフォニウム塩系化合物1部、シランカップリング剤としてエポキシ系シラン1部を配合し、熱・紫外線硬化樹脂を調製した(屈折率1.573)。シリコン基板上に、この調製した熱・紫外線で化樹脂をスピンコート法により20 $\mu$ mの厚さに積層し、150℃2時間で硬化させ下部クラッド(屈折率1.590)を形成した。

【0033】次に、上記の調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により $8\mu$ mの厚さに積層し、フォトマスクを使用して、光量50mW/c  $m^2$ の紫外線を10分間照射して幅 $8\mu$ mの直線部を硬化させ、熱・光導波路のコア部(屈折率1.601)を形成した。その後、1502時間で未硬化部分を硬化させ、側面のクラッド部を形成した。更に、本実施例で調製した熱・紫 20外線硬化樹脂をスピンコート法により $20\mu$ mの厚さに積層し、1502時間で硬化した。

【0034】本実施例で作製した直線型光導波路の光損失を、波長1300nmの半導体レーザで調べたら、1.5dB/cmであった。Y分岐型光導波路の光損失を、波長1300nmの半導体レーザで調べたら、2.3~3.5dB/cmであった。

[0035]

【実施例3】脂肪族環状エポキシである3、4-エポキシシクロヘキシルメチル-3、4-エポキシシクロヘキ 30 サンカルボキシレート60部に、オキセタン化合物の3-エチル-3-フェノキシメチル)オキセタン40部、光重合開始剤として4、4-ビス(ジ(βヒドロキシエトキシ)フェニルスルフォニオ)フェニルスルフィドービス-ヘキサフルオロアンチモネート2部、熱硬化剤としてベンジル基を有する潜在性硬化剤のスルフォニウム塩系化合物1部、シランカップリング剤としてエポキシ系シラン1部を配合し、熱・紫外線硬化樹脂を調製した(屈折率1、501)。シリコン基板上に、この調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により20 $\mu$ m 40の厚さに積層し、180 で3時間で硬化させ下部クラッド(屈折率1、512)を形成した。

【0036】次に、上記の調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により $8\mu$ mの厚さに積層し、フォトマスクを使用して、光量 $50\,\mathrm{mW/c}^2$ の紫外線を10分間照射して幅 $8\mu$ mの直線部を硬化させ、熱・光導波路のコア部(屈折率1.535)を形成した。その後、 $180\,\mathrm{C}3$ 時間で未硬化部分を硬化させ、側面のクラッド部を形成した。更に、本実施例で調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により $30\mu$ mの厚さに 50

積層し、180℃3時間で硬化した。

【0037】本実施例で作製した直線型光導波路の光損失を、波長1300nmの半導体レーザで調べたら、2.5dB/cmであった。

12

[0038]

【実施例 4】ビニルエーテル系化合物であるシクロへキサンジメタノールジビニロルエーテル、50部に、脂肪族環状エポキシである3、4ーエポキシシクロへキシルメチルー3、4ーエポキシシクロへキサンカルボキシレート50部、光重合開始剤として4.4ービス(ジ( $\beta$ ヒドロキシエトキシ)フェニルスルフォニオ)フェニルスルフィドービスーへキサフルオロアンチモネート2部、熱硬化剤としてベンジル基を有する潜在性硬化剤のスルフォニウム塩系化合物1部、シランカップリング剤としてエポキシ系シラン1部を配合し、熱・紫外線硬化樹脂を調製した(屈折率1.485)。シリコン基板上に、この調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により20μmの厚さに積層し、180℃3時間で硬化させ下部クラッド(屈折率1.478)を形成した。

【0039】次に、上記の調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により $8\mu$ mの厚さに積層し、フォトマスクを使用して、光量 $50\,\mathrm{mW/c\,m^2}$ の紫外線を10分間照射して幅 $8\mu$ mの直線部を硬化させ、熱・光導波路のコア部(屈折率1.505)を形成した。その後、 $180\,\mathrm{C}3$ 時間で未硬化部分を硬化させ、側面のクラッド部を形成した。更に、本実施例で調製した熱・紫外線硬化樹脂をスピンコート法により $30\mu$ mの厚さに積層し、 $180\,\mathrm{C}3$ 時間で硬化した。

【0040】本実施例で作製した直線型光導波路の光損 失を、波長1300nmの半導体レーザで調べたら、 3.1dB/cmであった。

[0041]

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明による光導波路の作製方法によると、1種類の光・熱併用硬化樹脂を用いて、光硬化によりコア部を形成、加熱硬化によりクラッド部を形成するのみで光導波路が形成できるので、製造工程が簡略化される。

【0042】また、高分子材料を使用するので、所望のコア部・クラッド部寸法を有する光導波路を簡便に作製できる。導波路の形状は、実施例のような直線ばかりでなく、分岐、合流なども容易に実現できる。

【0043】また、高分子材料を用いた光導波路はガラス系や半導体系の光導波路に比べて低コスト化に対するポテンシャルが高い。こうしたことから、光通信分野で用いられる光集積回路や、光情報処理分野で用いられる光配線板等の光導波路部品を、高分子光学材料を用いて大量・安価に製造することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光導波路の作製方法を示す工程図である。

【図2】従来の光導波路の作製方法を示す工程図であ ス

【符号の説明】

- A 基板
- B 下部クラッド
- C コア部

D 上部クラッド

- E レジスト、
- F マスク
- G 側面のクラッド部
- H コア部用樹脂
- I 紫外線

【図1】

